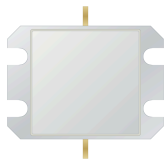
5700–7100 MHz GaN 内匹配功率晶体管 — PSAT 51 dBm (典型值)

LCT-5700-7100-PS51T · 5700–7100 MHz · GaN 内匹配功率晶体管.

RF 电气表参数: PSAT 51 dBm (典型值); 功率增益 11 dB (典型值); PAE 45 % (典型值). RF 测试条件: TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs.



CMW025B

先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。

Vg: C = 10 µF

RF 特性

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	f	5700	-	7100	MHz
饱和输出功率	-	50.5	51	-	dBm
功率增益	-	10.5	11	-	dB
功率附加效率	-	40	45	-	%
功率增益平坦度	-	-	-	1.5	dB

直流偏置与电流

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
漏极工作电压	-	-	-	-	28	V
栅极工作电压	-	-	-	-	[-3.2, -2.4]	V

极限参数

极限参数，不作为正常工作设定值。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
漏源最大正向电压	-	-	-	32	V
栅极最低偏置电压	-	-5	-	-	V
储存温度	-	-65	-	150	°C
最大输入功率	-	-	-	42	dBm

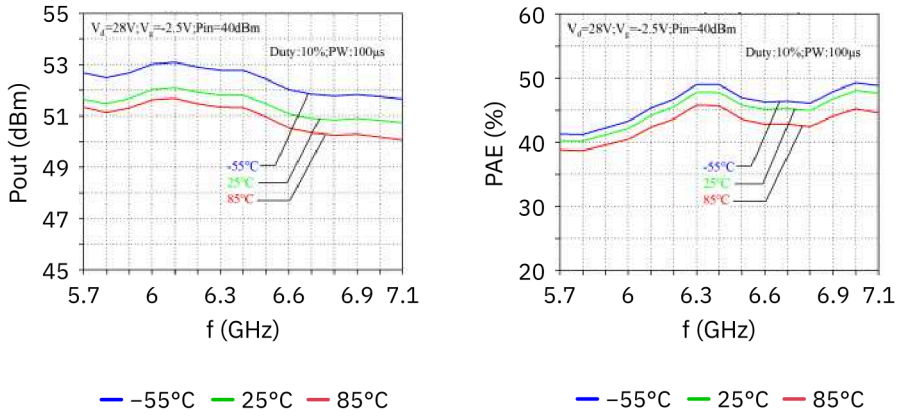
当前出版记录 · 1.5 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.4.

集成说明

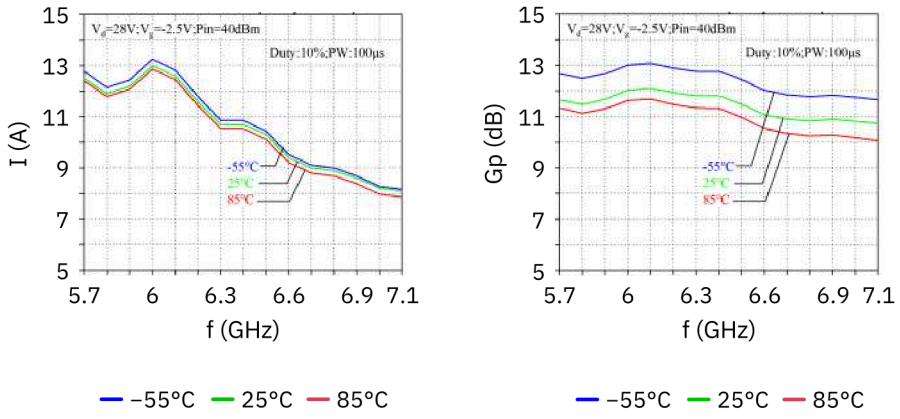
CMW025B 先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。 Vg: C = 10 µF G: RF输入 D: RF输出 S: 源极／接地

性能曲线

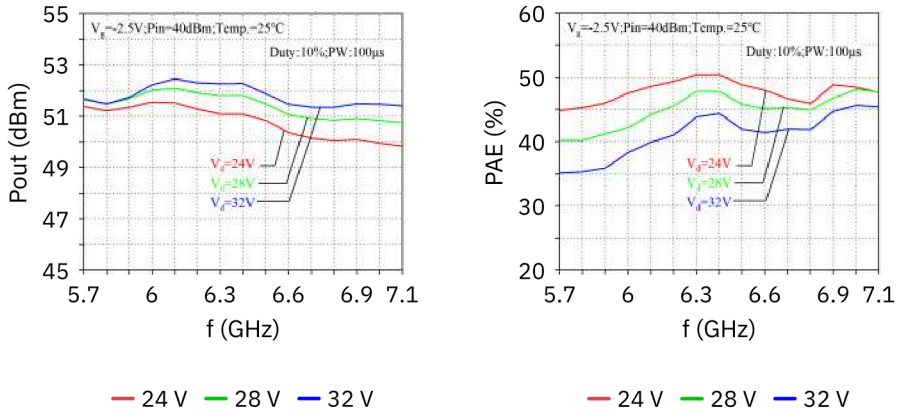
请结合每张图标明的工作条件阅读。



−55°C 25°C 85°C

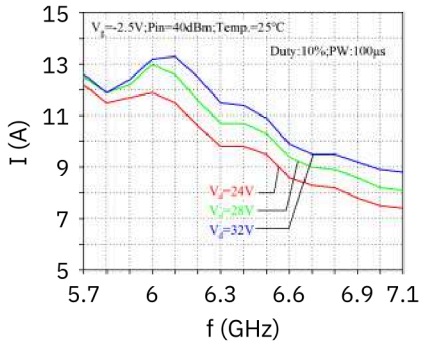


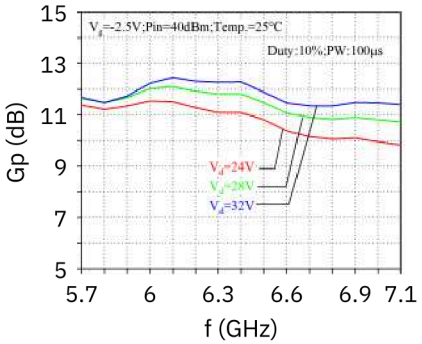
−55°C 25°C 85°C



24 V 28 V 32 V

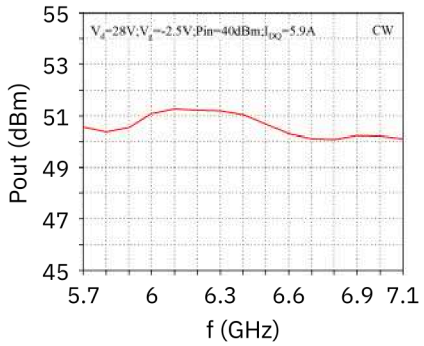
输出功率、功率附加效率、漏极电流、功率增益。 第1–4图: Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 μs; Temp = −55 / +25 / +85°C. 第5–6图: Vd = 24 / 28 / 32 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 μs.

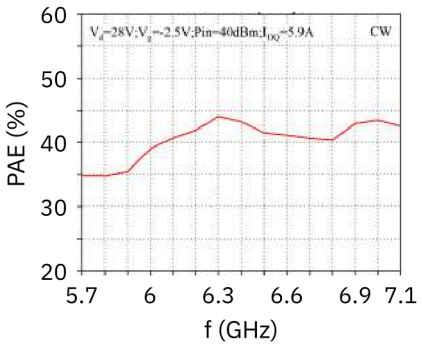


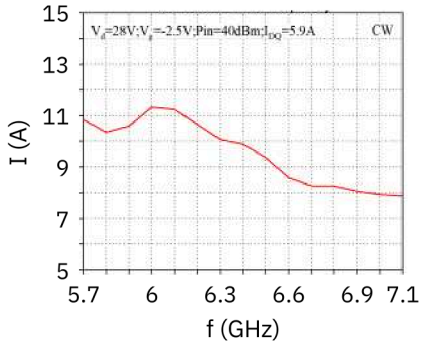


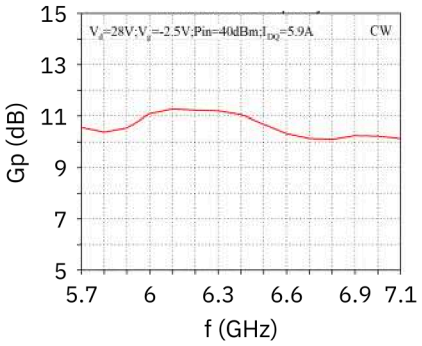
24 V 28 V 32 V

24 V 28 V 32 V

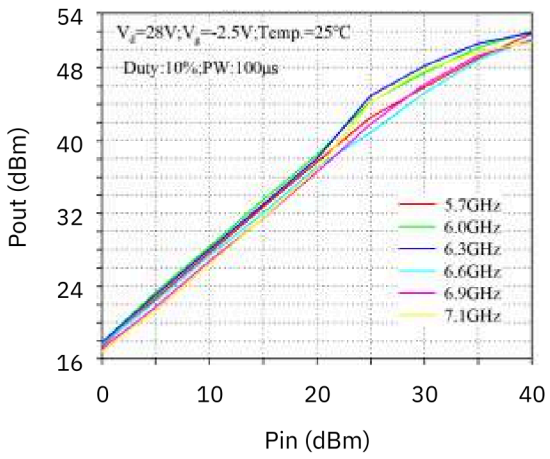


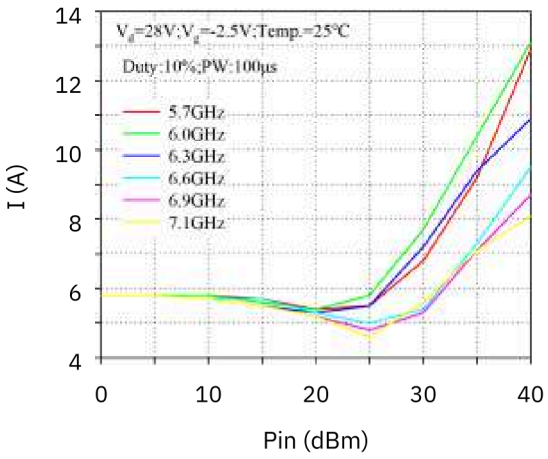






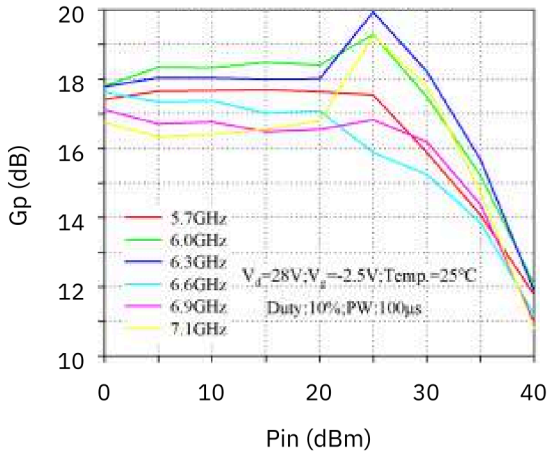
输出功率、功率附加效率、漏极电流、功率增益。 第1–2图: Id, Gp; Vd = 24 / 28 / 32 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 μs. 第3–6图: Pout, PAE, Id, Gp; Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; IDQ = 5.9 A; CW.





5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz

5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz



5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz

输出功率、漏极电流、功率增益。 Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 µs; Pin = 0–40 dBm.

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。